第 19 卷第 10 期 Vol.19 No.10

文章编号:1004-0609(2009)10-1802-07

W 含量对(Mo_{1-x}, W_x)Si₂复合材料力学性能和 高温氧化性能的影响

彭 可,易茂中,冉丽萍,葛毅成,杨 琳

(中南大学 粉末冶金国家重点实验室,长沙 410083)

摘 要:以 Mo、W 和 Si 粉为原料,采用自蔓延热爆合成和热压工艺制备不同 W 含量的(Mo_{1-x}, W_x)Si₂ 复合材料,研究 W 含量对(Mo_{1-x}, W_x)Si₂ 复合材料的力学性能和高温抗氧化性能的影响。结果表明:随着 W 含量的增加, $(Mo_{1-x}, W_x)Si_2$ 复合材料的力学性能逐渐增加,氧化激活能逐渐降低; $(Mo_{0.5}, W_{0.5})Si_2$ 复合材料的室温抗弯强度、1200 高温抗弯强度、硬度和断裂韧性分别为 363 MPa、480 MPa、9.28 GPa 和 3.82 MPa·m^{1/2},与纯 MoSi₂比较,分别增加了 40.7%、112.4%、12.1%和 27.3%; $(Mo_{1-x}, W_x)Si_2$ 复合材料在 1 673~1 873 K 空气中能形成致密的氧化 层,氧化增量符合抛物线规律。

关键词:二硅化钼;合金化;力学性能;氧化行为 中图法分类号: TG 148 文献标识码: A

Effect of W content on mechanical properties and high temperature oxidation behavior of (Mo_{1-x}, W_x)Si₂ composites

PENG Ke, YI Mao-zhong, RAN Li-ping, GE Yi-cheng, YANG Lin

(State Key Laboratory of Powder Metallurgy, Central South University, Changsha 410083, China)

Abstract: $(Mo_{1-x}, W_x)Si_2$ composites were prepared by the thermal explosion mode of SHS followed by hot pressing using Mo, W and Si powders as raw materials. The effect of W content on the mechanical properties and high temperature oxidation behavior of $(Mo_{1-x}, W_x)Si_2$ composites were studied. The results show that with increasing W content, the mechanical properties of $(Mo_{1-x}, W_x)Si_2$ composites gradually increase, and the activation energies of $(Mo_{1-x}, W_x)Si_2$ composites gradually decrease. The room temperature bending strength, high-temperature flexural strength at 1 200 , hardness and fracture toughness of $(Mo_{0.5}, W_{0.5})Si_2$ composite are 363 MPa, 480 MPa, 9.28 GPa and 3.82 MPa·m^{1/2}, respectively, increased by 40.7%, 112.4%, 12.1% and 27.3% when compared with those of the monolithic MoSi₂. $(Mo_{1-x}, W_x)Si_2$ composites can form compact oxidation layers in the air at 1673–1 873 K, and oxidation mass gain is accordance with parabolic law.

Key words: molybdenum disilicide; alloying; mechanical properties; oxidation behavior

金属间化合物 MoSi₂因具有高熔点(2 030)、低 密度(6.24 × 10³ kg/m³)、良好的导热性和导电性以及 优异的高温抗氧化能力而被认为是最有前途的高温 结构材料,然而其低温脆性和高温蠕变限制了其实际 应用^[1-2]。合金化是强韧化 $MoSi_2$ 的一种有效方法,但 由于 $MoSi_2$ 具有特殊的晶体结构,只有少数硅化物可 作为其合金化组元,如 WSi_2 、 $NbSi_2$ 、 $CoSi_2$ 、 Mo_5Si_3 和 Ti_5Si_3 等^[3]。其中, WSi_2 与 $MoSi_2$ 具有相同的晶体

基金项目:国家自然科学基金资助项目(50472078);教育部博士点基金资助项目(20040533006)

收稿日期:2008-11-21;修订日期:2009-04-28

通信作者:易茂中,教授,博士;电话:0731-8830894;Email:yimaozhong@126.com

结构和相近的点阵晶格常数,二者能以任何比例混合, 形成合金化合物(Mo,W)Si₂,其蠕变速率低于 $MoSi_2^{[4-5]}$ 。($Mo_{0.5}$, $W_{0.5}$)Si₂固溶复合材料在1500 时 的屈服强度要比纯 $MoSi_2$ 的屈服强度高 8~10 倍^[3],且 由 WSi_2 合金化制备的 $MoSi_2$ 发热体具有更好的高温 强度,可以在氧化条件下使用至1900 ^[4]。

本文作者以 Mo、W 和 Si 粉为原料,采用自蔓延 热爆合成和热压工艺制备了致密的(Mo,W)Si₂ 复合材 料,研究 W 含量对(Mo,W)Si₂ 复合材料力学性能及高 温抗氧化性能的影响,为开发性能更优异的 MoSi₂基 高温结构材料提供实验参考和理论依据。

1 实验

以 Mo 粉(平均粒度 1 μ m, 纯度 99.99%)、W 粉(平 均粒度 1 μ m, 纯度 99.99%)和 Si 粉(平均粒度 5 μ m, 纯度 99.0%)为原料,采用自蔓延热爆合成制备不同 W 含量的(Mo_{1-x},W_x)Si₂复合粉末^[6-7]。将热爆合成块体粗 碎后,再经 WL-1 型行星球磨机粉碎研磨 5 h,研磨 后粉末的平均粒径约为 5 μ m,经干燥、过筛,在氩气 保护下热压,热压模具为自制 C/C 复合材料模具,热 压工艺为 1 700 , 50 MPa,60 min。 采用 Archimedes 排水法测量试样的体积密度;室 温和高温抗弯强度均采用三点弯曲法测定,试样尺寸 为 3 mm×4 mm×36 mm,跨距 30 mm,测试加载速 率为 0.5 mm/min。采用直通切口三点弯曲梁(SENB) 法测定断裂韧性,试样尺寸为 5 mm×2.5 mm×30 mm,切口宽度约为 0.20 mm,切口深度为 2.50 mm, 加载速率为 0.05 mm/min。将试样表面抛光后,在 HVS-120型维氏硬度计上采用 100 N的压头载荷测试 复合材料的硬度。

氧化实验样品尺寸为 10 mm × 10 mm × 5 mm,用 SiC 砂纸抛光其表面后,浸入丙酮在超声波容器中清 洗。在进行氧化实验前,先测量样品的尺寸,计算出 样品的总表面积。氧化增量数据用单位面积上的增量 来计算。循环氧化实验在温度为1 400~1 600 的空 气自然对流的箱式炉中进行,每隔一定的时间取出样 品,自然冷却后采用天平(感应量 1 × 10⁻⁴ g)称其质量, 样品氧化时间累积为 120 h。

通过 MeF3A 型光学金相显微镜观察试样的组织 结构,并采用 Q520 图像分析软件测定晶粒大小;用 JSM-6360LV 型扫描电镜观察断口形貌及复合材料高 温氧化后的截面形貌,用 Rigaku-3014 型 X 射线能谱 仪对复合材料高温氧化表面进行成分分析。



图 1 $MoSi_2$ 和(Mo, W)Si_2复合材料的偏光金相照片

Fig.1 Polarizing optical micrographs of $MoSi_2$ and $(Mo, W)Si_2$ composites: (a) $MoSi_2$; (b) $(Mo_{0.9}, W_{0.1})Si_2$; (c) $(Mo_{0.7}, W_{0.3})Si_2$; (d) $(Mo_{0.5}, W_{0.5})Si_2$

2 结果及分析

2.1 复合材料的显微组织

图 1 所示为 MoSi₂ 及(Mo, W)Si₂ 复合材料的偏光 金相照片。在偏光下由于晶粒的各向异性而显示出不 同颜色。MoSi₂、(Mo_{0.9}, W_{0.1})Si₂、(Mo_{0.7}, W_{0.3})Si₂ 和 (Mo_{0.5}, W_{0.5})Si₂ 试样的平均晶粒大小分别 17.2、16.8、 15.6 和 14.2 μ m。随着 W 含量的增加,晶粒逐渐减小, 表明 W 能抑制晶粒的长大^[8]。通过 Archimedes 排水 法测得各试样的相对密度大于 98.0%。从图 1 可以看 出,在晶粒的晶界及晶粒中分布着少量的黑色相,结 合断口形貌 SEM 分析,黑色相为孔洞。

2.2 复合材料的力学性能

W 含量对(Mo_{1-x} , W_x)Si₂ 复合材料力学性能的影响如图 2 所示。从图 2 可以看出,随着 W 含量的增加, (Mo_{1-x} , W_x)Si₂ 复合材料的室温抗弯强度、1 200 高 温抗弯强度、硬度和断裂韧性均逐渐增加,其中 ($Mo_{0.5}$, $W_{0.5}$)Si₂ 复合材料的室温抗弯强度、1 200 高 温抗弯强度、硬度和断裂韧性分别为 363 MPa、480 MPa、9.28 GPa 和 3.82 MPa·m^{1/2}。与纯 MoSi₂比较, 分别增加了 40.7%、112.4%、12.1%和 27.3%。INUI 等^[9]研究发现,采用高温熔炼法制备的(Mo_{1-x} , W_x)Si₂ 固溶体的强度和硬度均随 W 含量的增加而增加,而且 随着温度的升高,固溶体强度的增加更为显著。

本文作者根据固体与分子经验电子理论(EET),对 MoSi2和WSi2的价电子结构进行了定量计算,并利用 平均原子模型对(Mo1-r, Wr)Si2固溶体进行了价电子结 构分析^[10-13]。根据 EET 理论,材料的强度可以由 η (共 价电子总数占总的价电子数的比)表示,该指标越大, 则材料的强度越大^[14]。共价电子数的大小反映了原子 的结合力,其结合越强,结合能越高,宏观上表现为 硬度越高^[14-16]。研究表明,在C11_b型体心正方结构 的(Mo1-x, Wx)Si2 固溶体中,沿<331>位向分布的 Mo(W)-Si 原子键最强,随着W含量的增加,固溶体 最强键上共价电子数、最强键键能和 n 值升高,表明 随着 W 含量的增加,固溶体的硬度和强度逐渐增 加^[11]。这从晶体的价电子结构解释了随着 W 含量的增 加,材料硬度和强度随之增加的本质原因。另外,随 着 W 含量的增加,复合材料的平均晶粒逐渐减小,对 材料也起到了细晶增强增韧作用。



图 2 W 含量对复合材料室温抗弯强度、1 200 高温抗弯 强度、硬度和断裂韧性的影响

Fig.2 Effect of W content on room temperature bending strength, high-temperature flexural strength at 1 200 (a) and hardness, fracture toughness (b) for composites

图 3 所示为 MoSi₂和(Mo_{0.5}, W_{0.5})Si₂的断口形貌。 从图 3 可以看出, MoSi₂和(Mo_{0.5}, W_{0.5})Si₂的断裂方式 均为解理断裂。MoSi₂和(Mo_{0.5}, W_{0.5})Si₂的断口形貌的 "解理台阶"均非常明显,较大颗粒上也可见较为细 密的解理台阶,它们都是裂纹沿着一族相互平行而高 度不同的解理面扩展而形成的。由众多台阶汇集形成 解理断口最典型的河流花样特征,其形貌如图 3(b)和 (d)所示。

2.3 复合材料的高温氧化动力学曲线

图 4 所示为不同 W 含量的(Mo, W)Si₂ 复合材料在 不同温度下流动空气中氧化得到的氧化增量与时间的 关系。从图 4 可以看出,试样的氧化增量与氧化时间



图 3 MoSi₂和(Mo_{0.5},W_{0.5})Si₂的断口形貌

Fig.3 Fractural morphologies of $MoSi_2$ ((a), (b)) and $(Mo_{0.5}, W_{0.5})Si_2((c), (d))$





图4 不同W含量 $(Mo_{1-x}, W_x)Si_2$ 复合材料在不同 温度下氧化增量与时间的关系

Fig.4 Relationship between oxidation increment and time of $(Mo_{1-x}, W_x)Si_2$ composites with different W contents at different temperatures: (a) 1 673 K; (b) 1 773 K; (c) 1 873 K 呈抛物线规律,氧化反应初期氧化增量较快随后增量 减慢,可以用式(1)表达,且在相同的氧化温度下,氧 化增量随着 W 含量的提高而增加,

$$\Delta m^2 = k_{\rm p} t + c \tag{1}$$

式中: Δm 为单位面积质量增加;t是氧化时间;c为 常数; k_p 为抛物线速率常数,遵循 Arrhemius 方程。

$$K_p = k_0 \exp(-\frac{Q}{RT}) \tag{2}$$

式中: k₀为常数; Q 为化学反应激活能,表征发生化 学反应时需要越过的能垒,对于氧化反应,则表征氧 化过程进行的难易程度; T 为绝对温度; R 为摩尔气 体常数。将式(2)两边取对数,得到

$$\ln k_{\rm p} = \ln k_0 - \frac{Q}{RT} \tag{3}$$

从式(3)可以看出对 lnk_p与 1/T 作图,由直线斜率 即可确定氧化激活能 Q 的值,从而可以推断不同反应 的难易。因此,对不同 WSi₂含量的复合材料在 1 673~ 1 873 K 氧化速率常数的对数 lnk_p与 1/T 作图(见图 5), 进一步计算出氧化激活能,其结果如表 1 所列。从表 1



图5 不同W含量 $(Mo_{1-x}, W_x)Si_2$ 复合材料的氧化速度常数与 温度的关系

Fig.5 Relationship between oxidation speed constant and temperature of $(Mo_{1-x}, W_x)Si_2$ composites with different W contents

表1 不同W含量的 $(Mo_{1-x}, W_x)Si_2$ 复合材料的活化能

Table 1 Activate energy of $(Mo_{1-x}, W_x)Si_2$ composites withdifferent W contents

x	0	0.1	0.3	0.5
$Q/(kJ \cdot mol^{-1})$	159.6	154.8	141.7	131.5

可以看出,激活能随着 W 含量的增加逐渐降低,从而, 所需要越过的能垒也随之降低,抗氧化性能有所降低。

2.4 氧化产物的相组成与形貌分析

图 6 分别所示为 MoSi₂和(Mo_{0.5},W_{0.5})Si₂复合材 料在不同温度氧化 3 h 后表面氧化膜的 XRD 谱。MoSi₂ 在 1 673、1 773 和 1 873 K 氧化 3 h 后表面成分均为 MoSi₂、Mo₅Si₃和 SiO₂; (Mo_{0.5},W_{0.5})Si₂复合材料在 1 673、1 773 和 1 873 K 氧化 3 h 后表面成分均为 (Mo_{0.5},W_{0.5})Si₂、(Mo_{0.5},W_{0.5})₅Si₃和 SiO₂。MoSi₂在高温 下的氧化反应如下:

$$5MoSi_2 + 7O_2 = Mo_5Si_3 + 7SiO_2$$

$$\tag{4}$$

从 XRD 结果可以推断(Mo_{0.5},W_{0.5})Si₂ 的高温氧化 反应如下:

$$5(Mo_{0.5}, W_{0.5})Si_2 + 7O_2 = (Mo_{0.5}, W_{0.5})_5Si_3 + 7SiO_2$$
 (5)

Mo₅Si₃和(Mo_{0.5},W_{0.5})₅Si₃峰的强度均随着氧化温



图 6 MoSi₂和(Mo_{0.5}, W_{0.5})Si₂在不同温度氧化 3 h 后表面氧 化膜的 XRD 谱

Fig.6 XRD patterns of oxidation coatings formed on $MoSi_2$ (a) and $(Mo_{0.5}, W_{0.5})Si_2$ (b) oxided at different temperatures for 3 h



图7 MoSi₂和(Mo_{0.5},W_{0.5})Si₂在1773 K 氧化120 h 后表面氧化 膜的 XRD 谱

Fig.7 XRD patterns of coating formed on $MoSi_2$ (a) and $(Mo_{0.5}, W_{0.5})Si_2$ (b) oxided at 1 773 K for 120 h

度的升高而增强,表明随着氧化温度的升高,试样表面的 Mo_5Si_3 或 $(Mo_{0.5},W_{0.5})_5Si_3$ 含量增加。 SiO_2 在不同温度下,结晶状态不一样,1 873 K 生成的 SiO_2 为非晶态。在对SiC高温氧化性能的研究中也发现,当温

度在 1 773 K 以上氧化后,冷却到室温时存在非晶态的 SiO₂;而当温度在 1 773 K 以下时,氧化物均为晶态 SiO₂^[17]。图 7 所示为 MoSi₂和(Mo_{0.5},W_{0.5})Si₂复合材料在 1 773 K 氧化 120 h 后表面成分的 XRD 谱。由图 7 可以看出,经过 120 样 h 长时间氧化后,SiO₂为非晶态。

 $MoSi_2$ 和($Mo_{0.5}$, $W_{0.5}$)Si_2复合材料在1773K空气 中恒温氧化3和120h的氧化层截面形貌如图8所示。 从图8可以看出, $MoSi_2$ 和($Mo_{0.5}$, $W_{0.5}$)Si_2复合材料在 1773K空气中恒温氧化3和120h后,氧化层均比较 致密,且与基体的附着性很好,因此形成较好的阻挡 氧扩散进入的障碍。在相同试验条件下, ($Mo_{0.5}$, $W_{0.5}$)Si_2复合材料表面氧化层厚度要大于纯 $MoSi_2$ 材料,这进一步证实了前面氧化动力学曲线分 析所得到的结论。

3 结论

 1) 采用热爆合成和热压烧结制备了致密的 (Mo_{1-x},W_x)Si₂复合材料。



图 8 MoSi₂和(Mo_{0.5}, W_{0.5})Si₂复合材料在 1 773 K 空气中恒温氧化 3 h 和 120 h 的氧化层截面形貌 Fig.8 Cross-sectional morphologies of coatings formed on MoSi₂ and (Mo_{0.5},W_{0.5})Si₂ oxided at 1 773 K for 3 h and 120 h: (a) MoSi₂, 3 h; (b) (Mo_{0.5},W_{0.5})Si₂, 3 h; (c) MoSi₂, 120 h; (d) (Mo_{0.5},W_{0.5})Si₂, 120 h

2) 随着 W 含量的增加, $(Mo_{1-x}, W_x)Si_2$ 复合材料 的室温抗弯强度、1 200 高温抗弯强度、硬度和断裂 韧性均逐渐增加,其中 $(Mo_{0.5}, W_{0.5})Si_2$ 复合材料的室温 抗弯强度、1 200 高温抗弯强度、硬度和断裂韧性比 $MoSi_2$ 分别提高了 40.7%、112.4%、12.1%和 27.3%。 $(Mo_{1-x}, W_x)Si_2$ 复合材料的断裂方式为解理断裂。

3) 不同 W 含量的(Mo_{1-x},W_x)Si₂ 复合材料在
 1 400~1 600 空气中的能形成致密的氧化层,氧化增
 量符合抛物线规律。随着 W 含量的增加 (Mo_{1-x},W_x)Si₂
 复合材料的氧化激活能逐渐降低。

REFERENCES

- MITRA R. Mechanical behaviour and oxidation resistance of structural silicides[J]. International Materials Reviews, 2006, 51(1): 13-64.
- [2] PETROVIC J J, VASUDEVAN A K. Key developments in high temperature structural silicides[J]. Mater Sci Eng A, 1999, 261(1/2): 1–5.
- [3] PETROVIC J J, HONNELL R E. SiC reinforced-MoSi₂/WSi₂ alloy matrix composites[J]. Ceramic Engineering and Science Proceedings, 1990, 11(7/8): 734–744.
- [4] 金志浩,李世斌,高积强. MoSi₂ 基复相材料的研究进展[J]. 西安交通大学学报, 2001, 35(2): 199-202.
 JIN Zhi-hao, LI Shi-bin, GAO Ji-qiang. Research progress of MoSi₂ matrix composites[J]. Journal of Xi'an Jiaotong University, 2001, 35(2): 199-202.
- [5] PETROVIC J J. Toughening strategies for MoSi₂-based high temperature structural silicides[J]. Intermetallics, 2000, 8(9/11): 1175–1182.
- [6] 彭 可,易茂中,冉丽萍. 自蔓延热爆合成 MoSi₂-WSi₂ 复合 粉末[J]. 中国有色金属学报, 2005, 15(6): 870-875.
 PENG Ke, YI Mao-zhong, RAN Li-ping. Synthesis of MoSi₂-WSi₂ composite powders by thermal explosion mode of SHS[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2005, 15(6): 870-875.
- [7] 彭 可,易茂中,冉丽萍. MoSi₂-WSi₂复合材料自蔓延热爆合 成反应热力学[J].稀有金属材料与工程,2006,35(4):554-558. PENG Ke, YI Mao-zhong, RAN Li-ping. Reaction thermodynamics of MoSi₂-WSi₂ composites in the thermal explosion mode of SHS[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2006, 35(4): 554-558.
- [8] 张荣军,杨延清,刘红梅.SiC_p-WSi₂/MoSi₂复合材料的室温力 学性能[J]. 材料科学与工程学报,2008,26(1):101-103.
 ZHANG Rong-jun, YANG Yan-qing, LIU Hong-mei.
 Room-temperature mechanical properties of SiC_p-WSi₂/MoSi₂
 composites[J]. Journal of Materials Science and Engineering, 2008, 26(1): 101-103.

- [9] INUI H, NAKAMOTO T, ISHIKAWA K, YAMAGUCHI M. Plastic deformation of single crystals of (Mo_{1-x},W_x)Si₂ with the C11_b structure[J]. Materials Science and Engineering A, 1999, 261(1/2): 131–138.
- [10] 彭 可,易茂中,陶辉锦,冉丽萍. MoSi₂ 价电子结构及结合 能计算[J]. 中国有色金属学报, 2007. 17(2): 216-221.
 PENG Ke, YI Mao-zhong, TAO Hui-jin, RAN Li-ping. Valence electronic structure analysis and cohesive energy calculation of MoSi₂[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2007. 17(2): 216-221.
- [11] 彭 可. 合金化和纳米复合化制备(Mo,W)Si₂-SiC 材料及其性 能研究[D]. 长沙: 中南大学, 2008: 20-62.
 PENG Ke. Investigation of fabrication and properties of alloying and nano-particle compositing (Mo, W)Si₂-SiC[D]. Changsha: Central South University, 2008: 20-62.
- [12] 彭 可,易茂中,冉丽萍. WSi₂的价电子结构及其性能研究
 [J]. 稀有金属材料与工程,2007,36(10):1154-1158.
 PENG Ke, YI Mao-zhong, RAN Li-ping. Study on the valence electronic structure and properties of WSi₂ phases[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2007, 36(10):1154-1158.
- [13] 彭 可,易茂中,冉丽萍. MoSi₂和 WSi₂的价电子结构及性能 分析[J]. 金属学报, 2006, 42(11): 1125-1129.
 PENG Ke, YI Mao-zhong, RAN Li-ping. Analysis of valence electronic structures and properties of MoSi₂ and WSi₂[J]. Acta Metallurgica Sinica, 2006, 42(11): 1125-1129.
- [14] 张瑞林. 固体与分子经验电子理论[M]. 吉林: 吉林科学技术 出版社, 1993: 231-333.
 ZHANG Rui-lin. Empirical electron theory of solid and molecules[M]. Jilin: Jilin Science and Technology Press, 1993: 231-333.
- [15] 杜晓东,丁厚福,宣天鹏. CrB 价电子结构对其性能的影响[J].
 中国有色金属学报, 2005, 12: 1980–1985.
 DU Xiao-dong, DING Hou-fu, XUAN Tian-peng. Effect of valence electron structure on property of CrB[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2005, 12: 1980–1985.
- [16] 郑 勇, 熊惟皓, 宗校军. Ti(C, N)固熔体的价电子结构及其
 与硬度和塑性间的关系[J]. 稀有金属材料与工程, 2002, 31(1):
 13-16.

ZHENG Yong, XIONG Wei-hao, ZONG Xiao-jun. On the valence electron structure of Ti(C, N) solid solution and its relationship with hardness and plasticity[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2002, 31(1): 13–16.

[17] 常春,陈传忠,刘仲泉.反应结合 SiC 电热材料的高温氧化
 特性[J]. 硅酸盐学报, 2004, 32(8): 1040-1044.
 CHANG Chun, CHEN Chuan-zhong, LIU Zhong-quan.
 Oxidation characteristics of reaction-bonded silicon carbide
 electroheating material at high temperature[J]. Journal of The
 Chinese Ceramic Society, 2004, 32(8): 1040-1044.

(编辑 龙怀中)